

μPA46D

NPN Silicon Epitaxial Quad Transistor
High Current High Speed Switching
Industrial Use

大電流高速度スイッチング用 通信工業用

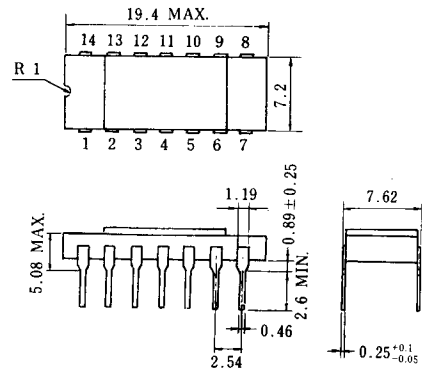
μPA46Dは、大電流高速度スイッチング用としてデュアルインラインパッケージに4個のトランジスタを組み込んだもので、電子計算機用コアダライブ、ワイヤードライブおよびリレードライブ等に最適です。

- スイッチングスピードが速い。
- 800 mA位までの高速スイッチングが可能。
- 14ピンデュアルインラインパッケージの採用により実装が容易。

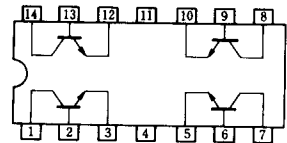
絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	45	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	5.0	V
コレクタ電流	I _C	1.0	A
全損失	P _T	0.8	W/unit
全損失	P _T	1.5	W/package
ジャンクション温度	T _j	175	°C
保存温度	T _{stg}	-65~+175	°C

外形図/Package Dimensions (Unit: mm)



電極接続/Connection Diagram (Top View)



電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =40 V, I _E =0			500	nA
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	V _{EB} =3.0 V, I _C =0			500	nA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =1.0 V, I _C =50 mA	50	70		
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} =1.0 V, I _C =500 mA	30	45		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =500 mA, I _B =50 mA		0.32	0.5	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =500 mA, I _B =50 mA		0.94	1.2	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =10 V, I _E =-50 mA	250	350		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} =10 V, I _E =0, f=1.0 MHz		6.0	10	pF
ターンオン時間	t _{on}	測定回路図参照		17	30	ns
蓄積時間	t _{stg}			45	70	ns
ターンオフ時間	t _{off}			60	90	ns